

隔离 Σ - Δ 调制器

产品简述

MS2401是一款二阶 Σ - Δ 调制器，集成片上数字隔离器，能将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续采样，无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为 ± 320 mV，转换后的数字码流的最高数据速率为20MHz。MS2401的VDD1采用5V电源供电，VDD2可采用5 V或3 V电源供电。

串行接口采用片上数字式隔离，可提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压。MS2401采用16引脚SOW封装，工作温度范围为 -40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 。

主要特点

- 16位无失码
- 16位时INL典型值为 $\pm 2\text{LSB}$
- 失调漂移： $1\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$
- 20MHz最大外部时钟速率
- 片上数字隔离器
- 集成基准电压
- $\pm 250\text{mV}$ 模拟输入电压（满幅 $\pm 320\text{mV}$ ）
- 低功耗工作
- 工作温度范围： -40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$
- SOW16封装
- 隔离耐压符合60s 5kVrms标准



SOW16

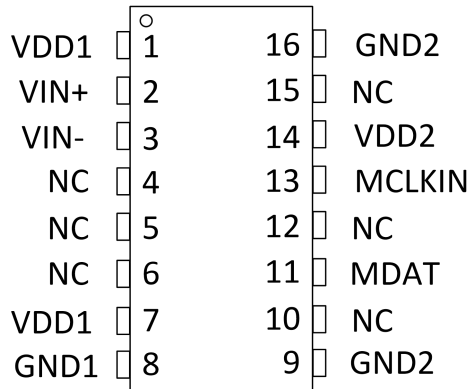
应用

- 交流电机控制

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS2401	SOW16	MS2401

管脚图

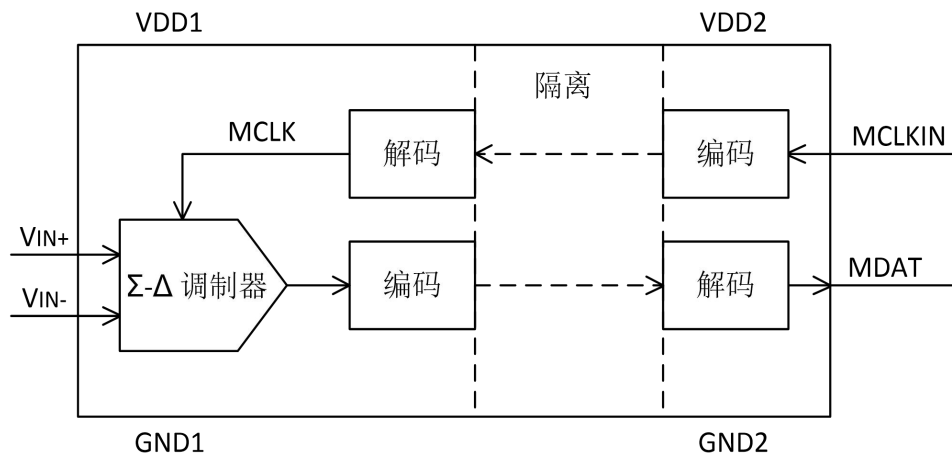


SOW16

管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1,7	VDD1	I	隔离侧电源
2	VIN+	I	模拟输入正端，额定范围为±250mV
3	VIN-	I	模拟输入负端，通常与 GND1 相连
4,6,10,12,15	NC	-	空脚
8	GND1	I	隔离侧地，这是隔离侧所有电路的接地基准点
9,16	GND2	I	非隔离侧地，这是非隔离侧所有电路的接地基准点
11	MDAT	O	串行数据输出，内部调制器的输出信号以串行数据流的形式，由该引脚输出到外部。每位数据在 MCLKIN 的上升沿逐位移出，并在下一个 MCLKIN 上升沿有效
13	MCLKIN	I	主机时钟输入，最高频率为 20MHz，MDAT 输出码流在 MCLKIN 上升沿有效
14	VDD2	I	非隔离侧电源

内部框图



极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
隔离侧供电电压	$V_{DD1-GND1}$	-0.3~6.5	V
非隔离侧供电电压	$V_{DD2-GND2}$	-0.3~6.5	V
模拟输入电压至 GND1	$V_{IN-GND1}$	-0.3~ $V_{DD1}+0.3$	V
数字输入电压至 GND2	$V_{MCLKIN-GND2}$	-0.3~ $V_{DD1}+0.5$	V
输出电压至 GND2	$V_{MDAT-GND2}$	-0.3~ $V_{DD2}+0.3$	V
输入电流（除电源脚外）	I_i	±10mA	mA
存储温度范围	Tstg	-65~+150	°C
结温	$T_j(MAX)$	150	°C
输入至输出电阻	R_{I-O}	10^{12}	Ω
输入至输出电容	C_{I-O}	2	pF
焊接温度（10s）	$T_{SOLDERING}$	260	°C
ESD(HBM)	ESD(HBM)	±3000	V

电气参数

推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
隔离侧供电电压	VDD1	4.5		5.5	V
非隔离侧供电电压	VDD2	3		5.5	V
工作温度范围	T _A	-40		+125	°C

电气参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
分辨率		滤波器输出截断至 16 位	16			Bits
积分非线性	INL	V _{IN+} =±200mV, f _{MCLKIN} =20MHz		±1.5	±7	LSB
		V _{IN+} =±250mV, f _{MCLKIN} =20MHz		±2.0	±13	
		V _{IN+} =±200mV, f _{MCLKIN} =20MHz		±1.5	±11	
		V _{IN+} =±250mV, f _{MCLKIN} =20MHz		±2	±46	
微分非线性	DNL	V _{IN+} = -250mV~250mV, f _{MCLKIN} =20MHz 保证 16 位无失码			±0.9	LSB
失调电压	V _{OS}	V _{IN+} = -250mV~250mV, f _{MCLKIN} =20MHz		±0.25	±0.5	mV
失调电压温度漂移	TC _{VOS}			1	3.5	μV/°C
失调电压电源漂移	VC _{VOS}			120		μV/V
增益误差	G _{ERR}	V _{IN+} = -250mV~250mV, f _{MCLKIN} =20MHz		0.07	±1.5	mV
增益误差温度漂移	TC _{GER}			23		μV/°C
增益误差电源漂移	VC _{GER}			110		μV/V
模拟输入特性						
输入电压范围	V _{IN+} - V _{IN-}	满足特定性能,满量程±320mV		±200	±250	mV
动态输入电流	I _{IA}	V _{IN+} = 500mV, V _{IN-} =0V f _{MCLKIN} =20MHz		±13	±18	μA
		V _{IN+} = 400mV, V _{IN-} =0V		±10	±15	

		$f_{MCLKIN}=20MHz$				
		$V_{IN+}=0V, V_{IN-}=0V, f_{MCLKIN}=20MHz$		0.08		
直流漏电流	I_{IL}			± 0.01	± 0.6	μA
输入电容	C_{IA}			10		pF
动态特性 $V_{IN+}=5kHz$						
信纳比	SINA D	$V_{IN+}=\pm 200mV, f_{MCLKIN}=5\sim 20MHz$ $T_A=-40\sim +85^{\circ}C$	76	82		dB
		$V_{IN+}=\pm 250mV, f_{MCLKIN}=5\sim 20MHz$ $T_A=-40\sim +85^{\circ}C$	71	82		
		$V_{IN+}=\pm 200mV, f_{MCLKIN}=5\sim 20MHz$ $T_A=-40\sim +125^{\circ}C$	72	82		
		$V_{IN+}=\pm 250mV, f_{MCLKIN}=5\sim 20MHz$ $T_A=-40\sim +125^{\circ}C$		82		
信噪比	SNR	$V_{IN+}=\pm 250mV, f_{MCLKIN}=5\sim 20MHz$ $T_A=-40\sim +125^{\circ}C$	81	83		dB
		$V_{IN+}=\pm 200mV, f_{MCLKIN}=5\sim 20MHz$ $T_A=-40\sim +125^{\circ}C$	80	82		dB
总谐波失真	THD	$V_{IN+}=-250mV\sim 250mV,$ $f_{MCLKIN}=20MHz$		-90		dB
峰值谐波杂散噪声	SFDR			-92		dB
有效位数	ENO B		12.3	13.3		Bits
绝缘瞬变抗扰度	CMTI		25	30		kV/ μs
逻辑输入特性						
输入高电平	V_{IH}		$0.8\times VDD2$			V
输入低电平	V_{IL}			$0.2\times VDD2$		V
输入电流	I_{IN}				± 0.5	μA
悬空态漏电流	I_{FSL}				1	μA
输入电容	C_{ID}				10	pF
逻辑输出特性						
输出高电平	V_{OH}	$I_O=-200\mu A$	$VDD2-0.1$			V

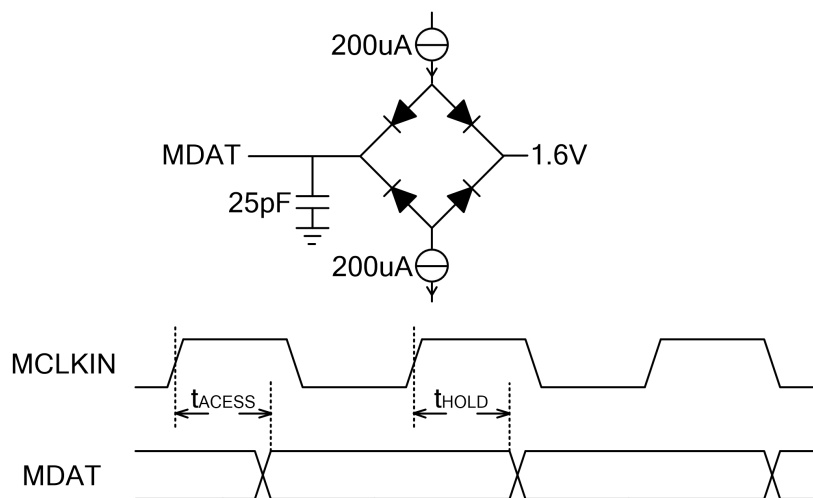
输出低电平	V_{OL}	$I_O = +200\mu A$			0.4	V
电源与功率特性						
隔离侧电源	VDD 1		4.5		5.5	V
非隔离侧电源	VDD 2		3		5.5	V
隔离侧电源电流	I_{DD1}	VDD1=5.5V		10	12	mA
非隔离侧电源电流	I_{DD2}	VDD2=5.5V		7	9	mA
		VDD2=3.3V		3	4	
功耗	P_D	VDD1=VDD2=5.5V		93.5		mW
时序规格						
外部输入时钟频率	f_{MCLKI} N		5		20	MHz
数据访问时间	t_{ACCESS}				25	ns
数据保持时间	t_{HOLD}		15			ns
输入时钟占空比	DR	$f_{MCLKIN} \leq 16MHz$	40%		60%	-
		$16MHz < f_{MCLKIN} \leq 20MHz$ 且 $VDD1=VDD2=5V \pm 0.5\%$	48%		52%	
隔离和安全相关特性						
输入输出瞬时耐受电压	V_{ISO}	持续 60s			5000	Vrms
最小外部气隙(间隙)	L(I01)	测量输入至输出端，空气最短距离			7.8	mm
最小外部爬电距离	L(I02)	测量输入至输出端，沿壳体最短距离			7.8	mm
最小内部间隙	d_{ISO}	隔离距离			0.018	mm

(1) 除非特别指定，VDD1=4.5V 至 5.5V，VDD2=3V 至 5.5V， $V_{IN+} = -200mV$ 至 $+200mV$ ， $V_{IN-} = 0V$ (单端)；

$T_A = -40^\circ C$ 至 $+125^\circ C$ ， $f_{MCLKIN} = 16MHz$ (最大值)，测试使用 Sinc3 滤波器，抽取率为 256。

(2) 所有电压均参照各自的地。

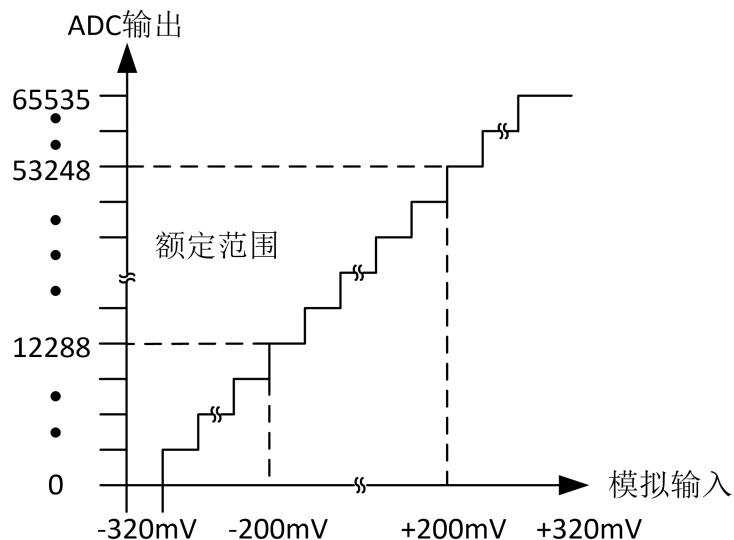
(3) 测量时序规格的负载电路如下图，时间定义为输出跨越 0.8V-2.0V 所需的时间。



应用信息

模拟输入

MS2401 通过二阶调制器级，能够将输入信号转换为输出码流。为重构原始信息，需经过数字滤波和抽取处理。推荐使用 Sinc3 滤波器。假设采用频率为 16 MHz 的外部时钟频率，如果抽取率为 256，则生成的 16 位字速率为 62.5 kHz。16 位输出模式下，MS2401 的传递函数如下图所示。



数字滤波器

系统的分辨率和吞吐率取决于所选的滤波器和所采用的抽取率。抽取率越高，系统的精度越高。但精度与吞吐率之间存在一定程度的折衷，因此，较高的抽取率产生吞吐率较低的解决方案。建议 MS2401 与一个 Sinc3 滤波器搭配使用。

接地和布局布线

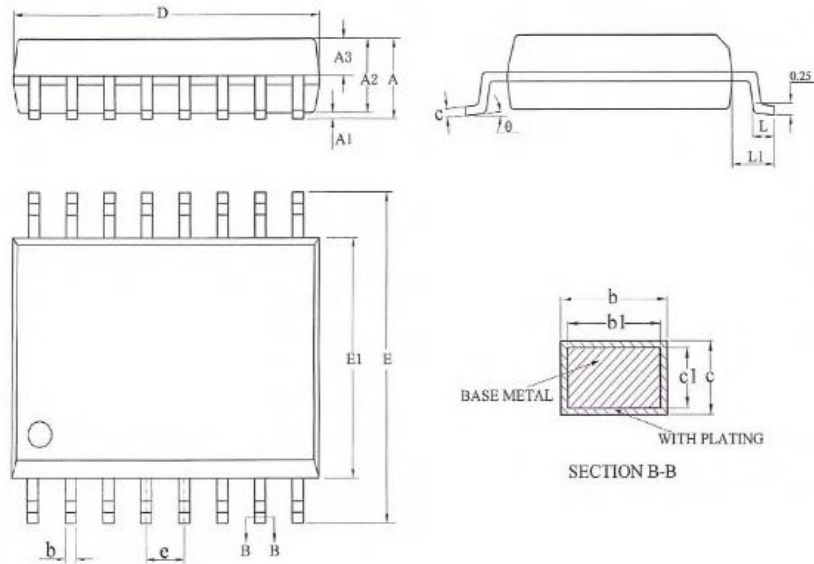
建议在 VDD1 和 VDD2 处分别连接 100 nF 电源去耦电容。在具有高共模瞬变的应用中，要确保隔离栅两端的电路板耦合最小。此外，电路板布局时要考虑，任何耦合都不会出现并影响特定器件侧所有的引脚。去耦电容应尽量靠近电源引脚。应尽量降低模拟输入端的串连电阻，以避免产生信号失真

隔离寿命

所有隔离结构在长时间使用或高电压作用下都易于击穿。还应注意，MS2401 的使用寿命随施加于隔离结构的波形类型而异。集成的数字隔离结构以不同速率衰减，这由波形是否为双极性交流、单极性交流或直流决定。

封装外形图

SOW16



Symbol	Millimeter		
	Min	Typ	Max
A	-	-	2.65
A1	0.10	-	0.30
A2	2.25	2.30	2.35
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.35	-	0.44
b1	0.34	0.37	0.39
c	0.25	-	0.31
c1	0.24	0.25	0.26
D	10.10	10.30	10.50
E	10.26	10.41	10.60
E1	7.30	7.50	7.70
e	1.27BSC		
L	0.55	-	0.85
L1	1.40BSC		
θ	0	-	8°

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



MS2401: 产品型号

XXXXXXX: 生产批号

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS2401	SOW16	1000	8	8000	1	8000

变更历史

版本号	修订日期	修订内容	页码
测试版	2021/06/16		

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失。
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产。



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)